

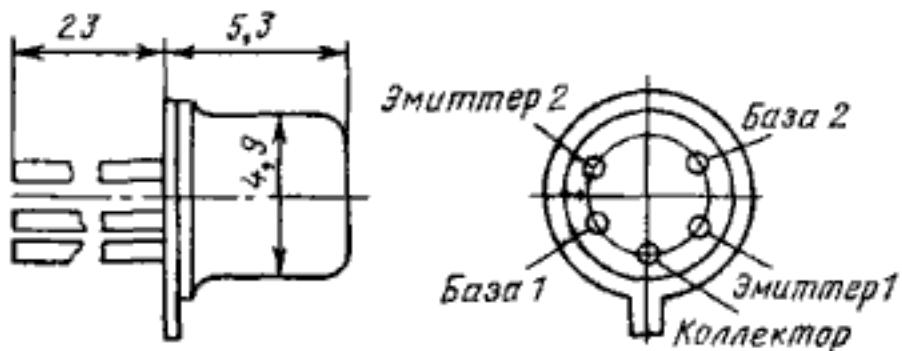
# 2T118А, 2T118Б, 2T118В, KT118А, KT118Б, KT118В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные двухэмиттерные  $p-n-p$  переключательные маломощные.

Предназначены для работы в схемах модуляторов.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 0,5 г.



## Электрические параметры

Падение напряжения на открытом ключе:

при  $I_B = 0,5$  мА не более:

при  $T = 298$  К:

2T118А, 2T118Б, KT118А, KT118Б . . . . . 0,2 мВ

2T118В, KT118В . . . . . 0,15 мВ

при  $T = 213$  К:

2T118А, 2T118Б, KT118А, KT118Б . . . . . 0,4 мВ

2T118В, KT118В . . . . . 0,3 мВ

при  $T = 398$  К . . . . . 0,6 мВ

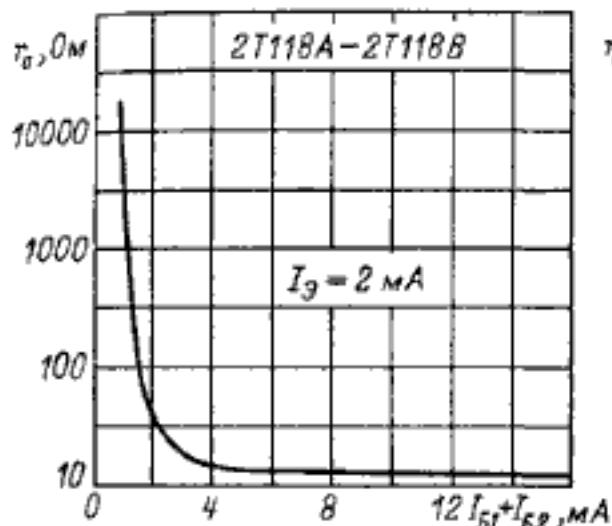
при $I_B = 1,5$ мА не более		
при $T = 298$ К:		
2T118A, 2T118B, KT118A, KT118B . . . . .	0,2	мВ
2T118B, KT118B . . . . .	0,15	мВ
при $T = 398$ К . . . . .	1,2	мВ
при $T = 213$ К . . . . .	0,18	мВ
Сопротивление открытого ключа не более		
при $I_E = 2$ мА, $I_B = 2$ мА		
при $T = 298$ К		
2T118A, 2T118B, KT118A, KT118B . . . . .	100	Ом
2T118B, KT118B . . . . .	120	Ом
при $T = 398$ К		
2T118A, 2T118B, KT118A, KT118B . . . . .	60	Ом
2T118B, KT118B . . . . .	70	Ом
при $I_E = 20$ мА, $I_B = 40$ мА		
при $T = 298$ К		
2T118A, 2T118B, KT118A, KT118B . . . . .	20	Ом
2T118B, KT118B . . . . .	40	Ом
при $T = 398$ К		
2T118A, 2T118B, KT118A, KT118B . . . . .	40	Ом
2T118B, KT118B . . . . .	80	Ом
при $T = 213$ К		
2T118A, 2T118B, KT118A, KT118B . . . . .	50	Ом
2T118B, KT118B . . . . .	80	Ом
Ток закрытого ключа при $U_{E3} = 30$ В 2T118A, KT118A		
и при $U_{E3} = 15$ В 2T118B, 2T118B, KT118B, KT118B		
не более		
при $T = 298$ К . . . . .	0,1	мкА
при $T = 398$ К . . . . .	5	мкА
при $T = 213$ К . . . . .	0,1	мкА
Напряжение на управляющих переходах при $T = 298$ К		
и $I_B = 20$ мА не более . . . . .	1	В
Асимметрия сопротивления открытого ключа при $T =$		
= 298 К, $I_B = 40$ мА, $I_E = 20$ мА не более . . . . .	20	%
Обратный ток коллектор-база 1, коллектор-база 2 при		
$T = 298$ К и $U_K = 15$ В не более . . . . .	0,1	мкА
Время выключения транзисторной структуры при $R_u =$		
= 1 кОм, $I_B = 20$ мА, $E_{вып} = 5$ В не более . . . . .	500	нс

## Предельные эксплуатационные данные

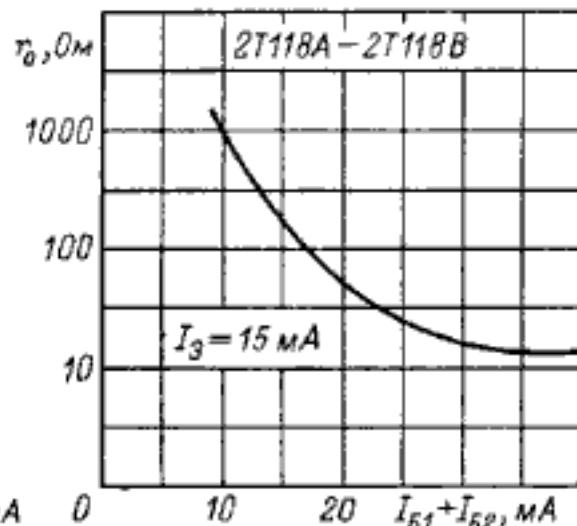
Постоянное напряжение управления между коллектором и базой транзисторной структуры при $R_{KB} \leq 10$ кОм	15 В
Постоянное напряжение на закрытом ключе между эмиттерами при $U_{upr} = 0$	
2T118A, KT118A . . . . .	30 В
2T118Б, 2T118В, KT118Б, KT118В . . . . .	15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база транзисторной структуры	
2T118A, KT118A . . . . .	31 В

2T118Б, 2T118В, КТ118Б, КТ118В . . . . .	16 В
Постоянный ток коллектора . . . . .	50 мА
Постоянный ток каждого эмиттера . . . . .	25 мА
Постоянный ток каждой базы . . . . .	25 мА
Постоянная рассеиваемая мощность при $T = 213 - 383$ К . . . . .	100 мВт
при $T = 398$ К . . . . .	62,5 мВт
Тепловое сопротивление переход-окружающая среда . .	0,4 К/мВт
Температура окружающей среды . . . . .	От 213 до 398 К

Примечание Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора при температуре пайки не более 523 К в течение времени не более 9 с Пайка производится паяльником мощностью не более 60 Вт и напряжением 6–12 В Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора Допускается одноразовый изгиб вывода на расстоянии 3 мм с радиусом изгиба не менее 0,5 мм



Зависимость сопротивления открытого ключа от тока базы



Зависимость сопротивления открытого ключа от тока базы

Зависимость падения напряжения на открытом ключе от тока базы

